

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG17N80E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 15A TO247AC</p>
	<p>Datenblätter:  SIHG17N80E-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status:</p>	<p>Lagerzustand: New original, 30 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von:</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

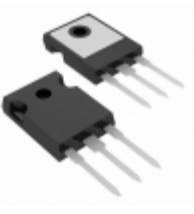
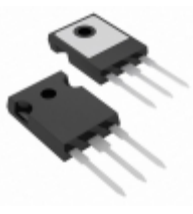
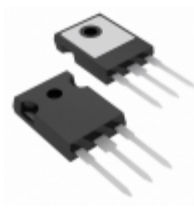
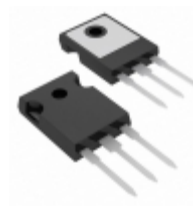



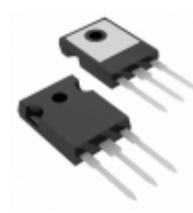
Spezifikationen

Teilenummer	SIHG17N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 15A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2408pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	122nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 15A (Tc) 208W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

SIHG17N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG17N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG17N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG17N80E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG17N60D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO247AC</p>	 <p>SIHG20N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 20A TO247</p>	 <p>SIHG20N50E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 19A TO-247AC</p>	 <p>SIHG20N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 19A TO-247AC</p>
 <p>SIHG17N60D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO247AC</p>	 <p>SIHG20N50C VISHYA SIHG20N50C VISHYA</p>	 <p>SIHG17N60D VISHAY SIHG17N60D VISHAY</p>	 <p>SIHG17N60D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG17N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHG17N80E-GE3 Datenblatt	SIHG17N80E-GE3-Datenblätter	SIHG17N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHG17N80E-GE3 Vishay	SIHG17N80E-GE3-Komponenten	SIHG17N80E-GE3-Bild	SIHG17N80E-GE3
SIHG17N80E-GE3 Electronic	SIHG17N80E-GE3 Hersteller	SIHG17N80E-GE3 Bild	SIHG17N80E-GE3 Teil
SIHG17N80E-GE3 Preis	SIHG17N80E-GE3 Original	SIHG17N80E-GE3 garantiert	SIHG17N80E-GE3 Inventar
SIHG17N80E-GE3 Neu	SIHG17N80E-GE3 Original	SIHG17N80E-GE3 garantiert	SIHG17N80E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited